

Импульсно-плазменное легирование кремния сурьмой

Gavrilov, Aleksei; Katšurin, G.A. Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 15-28 : ил https://www.ester.ee/record=b1291687*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

Импульсно-плазменный отжиг слоев кремния, имплантированных бором

Gavrilov, Aleksei; Katšurin, G.A. Электрофизические свойства полупроводниковых и диэлектрических материалов 1983 / с. 3-13 : ил https://www.ester.ee/record=b1291687*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/9447de85-407e-426e-843d-2f0c98097f4e>

Испульсное легирование кремния в сильноточном газовом разряде

Gavrilov, Aleksei; Katšurin, G.A. Письма в Журнал технической физики 1982 / с. 388-391 https://www.ester.ee/record=b2142356*est

К выбору конструкции фоточувствительных р-п переходов на основе антимонида индия

Gavrilov, Aleksei; Danilov, J.V.; Katšurin, G.A.; **Mere, Arvo** Физическая химия соединений AIBVI 1981 / с. 105-112 : илл https://www.ester.ee/record=b1533413*est <https://digikogu.taltech.ee/et/Item/dceb76ed-f60b-4ce9-b87e-618a41d25bb8>

Отжиг имплантированных слоев кремния в плазме импульсного газового разряда

Gavrilov, Aleksei; Katšurin, G.A. Физика и техника полупроводников = Physics and technics of semiconductors 1981 / с.1232-1234 https://www.ester.ee/record=b1263919*est

Сверхрезкие варикапы на эпитаксиальных пленках арсенида галлия, полученные с помощью ионного внедрения

Gavrilov, Aleksei; Katšurin, G.A. Электронная техника. Серия 2, Полупроводниковые приборы : научно-технический сборник 1977 / с. 99-103 https://www.ester.ee/record=b2160501*est

Формирование Р-слоев при внедрении ионов магния в InSb

Gavrilov, Aleksei; Danilov, J.V.; Katšurin, G.A.; **Mere, Arvo** Электронная техника. Серия 2, Полупроводниковые приборы : научно-технический сборник 1980 / с. 108-112 https://www.ester.ee/record=b2160501*est